


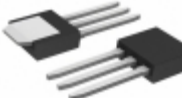
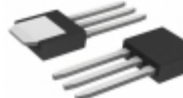





	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M007A090H</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M007A090H</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 7A TO220
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M007A090H.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1985 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M007A090H</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 7A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1985 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1969pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M007A090H ist neu im Original, Suche GP1M007A090H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M007A090H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M007A090H: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GP1M007A065CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK</p>	 <p><b>GP1M008A025PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A065PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A070FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>
 <p><b>GP1M008A050CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>	 <p><b>GP1M008A025HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220</p>	 <p><b>GP1M006A070F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 GP1FA501TZ	 GP1FA502RZ	 GP1FA513TZ	 GP1FA51TKOF	 GP1FA550RZ
 GP1FA550TZ	 GP1FA551	 GP1FA551TZ	 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553RZ0F
 GP1FA553TZ0F	 GP1FAV31TK0F	 GP1FAV50RK0F	 GP1FAV50TK0F	 GP1FAV51TK0F
 D GP1FD320TP0F	 GP1FM313TMF5	 GP1FM313TZMF	 GP1FSV51TK0F	 GP1L53VJ000F
 GP1L57J0000F	 GP1M003A050FG	 GP1M003A080CH	 GP1M003A090C	 GP1M006A070FH
 GP1M008A025PG	 GP1M009A020FG	 D GP1M009A090N	 GP1M010A060H	 GP1M010A080FH
 GP1M011A050FH	 D GP1M013A050H	 GP1M016A025CG	 GP1M016A060F	 GP1M016A060H
 GP1S092HCPI	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPKF	 GP1S093HCZ
 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 D GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F
 GP1S094HCZ0F	 GP1S096HCZ	 GP1S096HCZ0F	 GP1S096HCZ0F	 GP1S097HCZ0F

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited